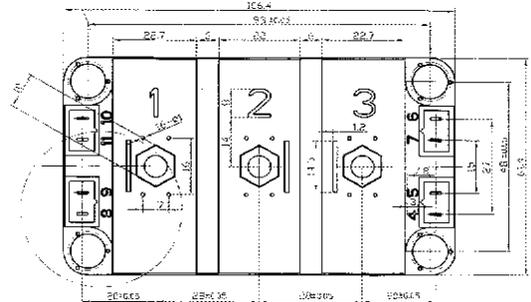
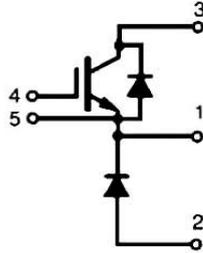
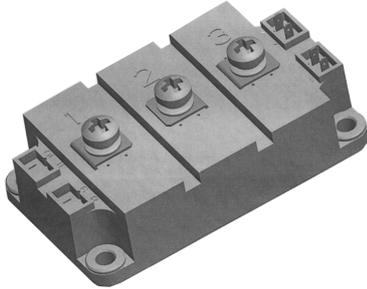


SDI400S12

SPT IGBT Modules

Dimensions in mm (1mm = 0.0394")



Absolute Maximum Ratings

$T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Symbol	Conditions	Values	Units
IGBT			
V_{CES}		1200	V
I_c	$T_c = 25(80)^\circ\text{C}$	565(400)	A
I_{CRM}	$T_c = 25(80)^\circ\text{C}$, $t_P = 1\text{ms}$	1130(800)	A
V_{GES}		± 20	V
$T_{Vj}(T_{stg})$	$T_{OPERATION} \leq T_{stg}$	$-40 \dots +150(125)$	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	AC, 1min	4000	V
Inverse Diode			
$I_{F=-I_c}$	$T_c = 25(80)^\circ\text{C}$	390(260)	A
I_{FRM}	$T_c = 25(80)^\circ\text{C}$, $t_P = 1\text{ms}$	1130(800)	A
I_{FSM}	$t_P = 10\text{ms}$; sin.; $T_j = 150^\circ\text{C}$	2900	A

SDI400S12

SPT IGBT Modules

Characteristics

T_c = 25°C, unless otherwise specified

Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Units
IGBT					
V _{GE(th)}	V _{GE} = V _{CE} , I _c = 12mA	4.8	5.5	6.45	V
I _{CES}	V _{GE} = 0; V _{CE} = V _{CE(s)} ; T _j = 25°C		0.2	0.6	mA
V _{CE(TO)}	T _j = 25(125)°C		1(0.9)	1.15(1.05)	V
r _{CE}	V _{GE} = 15V, T _j = 25(125)°C		3(4)	4(5)	mΩ
V _{CE(sat)}	I _c = 300A; V _{GE} = 15V; chip level		1.9(2.1)	2.35(2.55)	V
C _{ies}	under following conditions		26		nF
C _{oes}	V _{GE} = 0, V _{CE} = 25V, f = 1MHz		3		
C _{res}			3		
L _{CE}				20	nH
R _{CC+EE'}	res., terminal-chip T _c = 25(125)°C		0.35(0.5)		mΩ
t _{d(on)}	under following conditions: V _{CC} = 600V, I _c = 300A		110		ns
t _r	R _{Gon} = R _{Goff} = 4.7Ω, T _j = 125°C		60		ns
t _{d(off)}	V _{GE} = ± 15V		800		ns
t _f			60		ns
E _{on(E_{off})}			32(31)		mJ
Inverse Diode under following conditions:					
V _F = V _{EC}	I _F = 300A; V _{GE} = 0V; T _j = 25(125)°C		2(1.8)	2.5	V
V _(TO)	T _j = 25(125)°C		1.1	1.2	V
r _T	T _j = 25(125)°C		3	4.3	mΩ
I _{RRM}	I _F = 300A; T _j = 125°C		176		A
Q _{rr}	di/dt = 2400A/us		40		uC
E _{rr}	V _{GE} = V		16		mJ
Thermal Characteristics					
R _{th(j-c)}	per IGBT			0.055	K/W
R _{th(j-c)D}	per Inverse Diode			0.125	K/W
R _{th(c-s)}	per module			0.038	K/W
Mechanical Data					
M _s	to heatsink M6	3		5	Nm
M _t	to terminals M6	2.5		5	Nm
w				325	g

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9